

Точные часы реального времени DS32X35 с энергонезависимым ОЗУ

Компания Dallas Semiconductor, являющаяся собственностью компании Maxim Integrated Products, расширила семейство энергонезависимой памяти FRAM с представлением часов реального времени DS32B35 ($2\text{к} \times 8$ бит) и DS32C35 ($8\text{к} \times 8$ бит), которые являются самыми точными часами реального времени в промышленности. При работе на границах температурного диапазона данные микросхемы обеспечивают уход времени не более одного часа в год. Однако при работе в температурном диапазоне $0...+70^\circ\text{C}$ микросхемы способны достичь точности хода до одной минуты в год. Такая точность хода достигается за счет варьирования емкостной нагрузкой кварцевого резонатора в зависимости от температуры.

Входящее в состав DS32B35, DS32C35 сегнето-электрическое ОЗУ (FRAM) является действительно энергонезависимым, не только не требуя дополнительного источника энергии для хранения данных, но

и не привнося ограничений по быстродействию записи, свойственных

ЭСПЗУ или Flash-памяти. Для резервного питания часов реального времени может использоваться отделимая батарейка или конденсатор.

Доступ к часам реального времени и FRAM организован через интерфейс I²C.

Микросхемы выпускаются в 20-выводном, ROHS-совместимом корпусе SO (ширина 300 миллидьюмов). Доступны исполнения для коммерческого ($0...+70^\circ\text{C}$) и промышленного ($-40...+85^\circ\text{C}$) температурных диапазонов. Расположение выводов микросхем и типовая схема включения приведены на рис. 1 и 2 соответственно.

Информация предоставлена компанией Rainbow Tehnologies

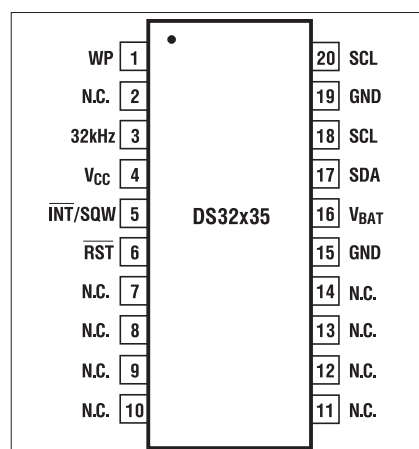


Рис. 1

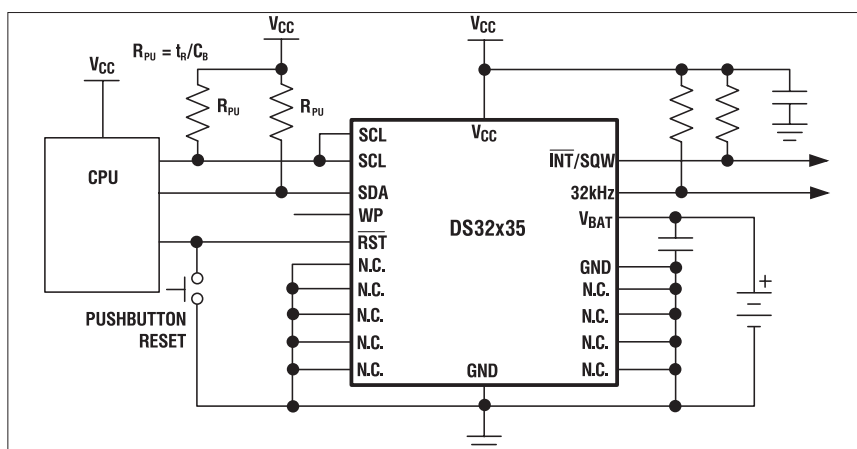


Рис. 2

EPSCOS: силовые конденсаторы для модулей IGBT

Компания EPCOS разработала новые силовые конденсаторы с шиной, которая сочетается с любыми модулями IGBT всех крупных производителей.

Компактный кубический корпус конденсаторов имеет размеры $280 \times 110 \times 120$ мм при факторе заполнения объема, равном 1, что позволяет использовать устройства в портативных конвертерах. Более того, устраняется необходимость в затратной сборочной работе и в использовании симметричных резисторов, которые применяются для других типов конденсаторов.

При номинальном рабочем напряжении 900 В постоянного тока силовые конденсаторы имеют номинальную емкость 1000 мкФ. Значение эквивалентной последовательной индуктивности для конденсатора, включая подводящую шину, не превышает 15 нГн. Таким образом, модули IGBT с большой скоростью нарастания не подвергаются перенапряжению при включении и выключении.

Информация предоставлена компанией ПЛАТАН

